2000 P23630 WO 10/600351 Dec 15 2003

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出題公開

@ 公 關 特 許 公 報 (A) 平3-3310

®Int. Cl. ⁸

識別配号

庁内篮理番号

❷公開 平成3年(1991)1月9日

H 01 G 9/02

3 3 1

7924-5E

審査嗣求 未請求 嗣求項の数 3 (全5頁)

日発明の名称 固体電解コンデンサの製造方法

②特 顋 平1-138407

20出 願 平1(1989)5月31日

発明者 金子 敦于

東京都骨梅市東骨梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株

式会社内

切出 願 人 日本ケミコン株式会社

東京都脅梅市東脅梅1丁目167番地の1

四代 理 人 弁理士 杉林 信益

1. 晃明の名称

固体包容コンデンサのほ違方法

- 2. 特許の求の范囲
- (1) 的包件金具函化物故园上に、一及式(1)

(式中、Zは一C(R*)中CH一、一S一、又は一N(H)一を殺し、R'、R*はそれぞれ私立して水器原子、又は低限アルコキシ茲を殺す。)で殺されるくり返し草位を有する固体包際質のポリマーの口を有する固体包際コンデンサを遅迫する方法において、一及式(I)、

(式中、Z、及びR は上記と同じ意味を収し、Y

は低度アルコキシ語、又は一S・(R→)(R→)・X→→ を哀し、R→及びR→は低度アルキル語を、Xはハ ログン瓜子を寂す)

で設される的四枚ポリマーの溶液を、前配的包体 金瓜酸化物位品に合設させ、次いでこの合設体を 品処型してこの高四枚ポリマーを前配一及式(1) で設されるポリマーに変えた他、ドーパントによ りドーピングすることを約回とする個体で終コン デンサの母泡方法。

- (2) 剪窓体ポリマーの溶液の溶燃として、ジクロロメタン、トリクロロエタン、クロロホルム、 又はテトラヒドロフランを用いる節求項.1 に記録 の固体包容コンデンサの環境方法。
- (3) 合松性の無処型を150℃以上で行う約束項1または2に配位の固体ではコンデンサの領追方法。
- 3. 兇明の降如な説明

(点以上の利用分分)

本兜明は、即吃你会以图化物故以上に、含汲、

熱処理により固体電解質のポリマー膜が形成された固体電解コンデンサの製造方法に関する。

(従来の技術及び発明が解決しようとする課題)

固体電解コンデンサは、アルミニウム、タクストリースを関形成性金属を指状またはブロックの状態が成性金属を指状またはブロックを発展している。 一般では、その表面に誘電体となる金属が、でいてその表面に関係を形成し、次いでその表面に性性を関係を関係を関係を表面には、の外部に導電性性を関係を引き出し手段を設けた構成を有している。従来この固体電解質には、二酸化マンガンが使用されており、液状の硝酸マンガンを熱分解して二酸化マンガンに変性させていた。

しかしこの方法によれば一度の工程における二 酸化マンガンの付着が僅かであるため同じ処理を 数度ないし十数度繰り返す必要があった。

このため、製造過程が極めて複雑になるとともに、熱分解時の高温や発生するNOIガスの酸化作用などによって、誘電体酸化物被膜を劣化させてしまう欠点があった。

そしてこのように一度多孔質講電体皮膜が損傷

されると、電解コンデンサはその耐電圧が低下したり、そのもれ電流が増大したり、あるいはその 多孔質請電体被膜の劣化が進行するなど様々な同

そこで最近では、固体電解質として二酸化マンガンの代わりに導電性ポリマーを使用することが検討されており、例えば導電性高分子として知られているポリ(pーフェニレンピニレン)、ポリ(チェニレンピニレン)、ポリ(ピロリレンピニレン)を固体電解質として用いることも試みられた。

しかしながら、これらのポリマーは安定で不溶 不融性であるため講覧体酸化物被膜にキャスティ ングすることが困難であり、固体電解コンデンサ の電解質として使用するには、その性質上無理が あった。

また従来法では低分子量のポリマーをキャスティングするため導電性が劣りドーピング方法にも同 題があった。

(課題を解決するための手段)

本発明はかかる課題を解決するためになされた

ものであり、誘電体金属酸化物被膜上に一般式([)

$$-CH=CH-$$
 (1)

(式中、Zは一C(R³)=CH~.-S~.又は一N(H)-を表し、R¹、R³はそれぞれ独立して水素原子、又は低級アルコキシ蓋を表す)

で表されるくり返し単位を有する固体電解質のポリマーの層を有する固体電解コンデンサを製造する方法において、一般式(II)

(式中、2、及びR'は上記と同じ意味を表し、Y は低級アルコキシ基、又は一S*(R*)(R*)・X *を表し、R*及びR*は低級アルキル基を、Xは ハロゲン原子を表す)

で表される前駆体ポリマーの溶液を前記誘駆体金 属酸化物液展に合浸させ、ついでこの合浸体を無 処理して、前記前駆体ポリマーを前記一般式(I) で表されるポリマーに変えた後。ドーパントによっ カドーピングすることを特徴とするものである。

すなわち本発明は、前駆体ポリマーが溶媒に溶解して使用することができ、誘電体金属酸化物被膜に容易にかつ高合浸率で含浸させることが可能である点に着目し、含浸体を熱処理後、ドーピング処理すれば、熱安定性、耐久性、電気的特性の優れた固体電解コンデンサが得られることを見出だし、本発明に到達したものである。

本発明で使用される前記一般式(II)で表される 前記ポリマーとしては、例えば次のくり返し単位 を有し、重合度3~1000のものが挙げられる。

特開平3-3310(3)

これらの前図件ポリマーは既知の方法、[polyner preprints, Japan Vol. 38, No. 1(1989)]により認定することができる。

例えば、一級式(日) R, R
t
 S'CH, $-$ CH, S' \sim R t (日)

(式中、R*,R*,R*,R*及びR*は低級アルキル凸を、 X,及びX:はハロゲン瓜子を寂し、R'、Zは一

and the second of the second second

役は、前駆你ポリマーを有過溶処又は水に溶溶して行う。有過溶燃としては、ジクロロメタン、クロロホルム、トリクロロエタン等のハロゲン化炭化水深、テトラヒドロフラン等の弱状エーテル等の前應体ポリマーを溶溶する低溶点有過溶燃であればいずれも使用することができる。合没処別は常圧合役法、減圧合役法のいずれも突如することが可能である。

前駆体ボリマーの目的ボリマーへの絵処型は、 例とば100~300℃の辺底で、好ましくは1 50~250℃の辺底に加熱し、放分ないし致吟 同、例えば約1時同行う。①合成の低い前駆体ボ リマーを使用したむ合、この絵処型により①合成 を恋めることができる。またこの絵処型は、理録 ガス、アルゴンガス等の不活性ガス穿囲気中で行 うこともできる。

一及式(1)であらわされる目的ポリマーのドー ヒングは化学的ドーピング、包気化学的ドーピン グのいずれの方法も採用することができる。

例えば、化学的ドーピングのドーパントとして

及式(1)、(1)における R^{\dagger} 、Zと同じΩ時を哀す)

で殺されるスルホニウムハライドの水溶液を低込下に包括性物質で処型し、一般式(目)において Y がーS・(R*)(R*)・X・で殺される ローの 南図 体ボリマーとし、次いで酸ローの 南図 体ボリマーとし、次いで酸ローの 南図 体ボリマーと し、次ので殺される ローの 南図 体ボリマーとする 方法、又は一級式(目)に 設 なスルホニウムハライドを低込下に アルコール、 水及び 担 5 性物質 と 共に 反応させて 直 谷 ローの 南図 体ボリマーと する 方法に より 日 記 する・

食図体ポリマーの別包体金瓜図化物は尽への合

は、日々の宮子交客性化合物及び宮子供与性化合物、即ち、(I)ヨウ窓、具容及びヨウ化具容等のハロゲン、(I)五ファ化ひ窓、五ファ化アンチモン、四ファ化ケイ窓、五虹化リン、塩化アルミニウムでの金以ハロゲン化物、(回)筬酸、可酸、フルオロの金以ハロゲン化物のでは、(F)三酸化イオウ、二酸化型溶液、ジフルオロスルホニルパーオキシドのごとを設化が、アトラシアノキノジメタン、2・3ージフロルーち・6ージシアノバラベンゾキノン、2・3ージブロムー5・6ージシアノバラベンゾキノン、(M)しi・Na.K等のアルカリ金具ながやげられる。

一方、又気化学的にドーピングするドーパントとしては、(I)PP。、SbP。、AoP。、SbCI。でのVa族元素のハロゲン化物アニオン、BP。でのOo族元素のハロゲン化物アニオン、IC(I, **)、Br**CI**
での沿ハロゲン酸アニオン草の酸イオンドーパント、及び(I)Li**、No**、K**でのアルカリ

特開平3-3310(4)

金属イオン、4級アンモニウムイオン等の陽イオンドーパント等、更には、pートルエンスルホン酸、ナフタレンー2ースルホン酸等のアリールスルホン酸の塩等を挙げることができるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。またこれらのドーパントは一種類、または2種類以上混合して使用してもよい。

本発明の方法で使用する誘電体酸化物被膜は、AliOsからなる被膜のほかTaiOs、NbiOs、TiOs、ZrOs等が挙げられ、例えばAlsOs被膜はアルミニウム層の表面を酸化処理して形成することができる。その酸化方法としては公知のであることが、例えば電圧70Vで隔極酸化する方法が挙げられる。この電気ののに気を用いることがのできる。で電気ののにするか、あるいはその使用するアルミニウム層の材質がどのようなものであるかにより使用電圧、化成時間等の条件を調整することができる。

本発明における誘電体金属酸化物被膜の基礎と なる例えばアルミニウム等の層はアルミニウムの 版、箔等をエッチング処理し多孔質化したものが 好ましい。このエッチング処理もアルミニウム層 をどの程度まで多孔質化するかにより適宜任意の 条件を選んで行うことができる。

(実施例)

以下に実施例にて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

実施例1

あらかじめエッチング処理した厚さ500μョの高純度アルミニウム板を70Vの電圧で陽酸化し、表面に酸化アルミニウムの誘電体層を形成した化成板に、 CH(OCHュ)ーCHューの緑り返車位をもつボリ(チェニレンピニレン)の前駆体ボリマー10重量%とテトラヒドロフルの前駆体ボリマー10重量%とテトラヒドロフラン・2000で1時間無処理した。次の電源度を高めるために、ルチジンテトラフルオロボーレイトのアセトニトリル溶液中で+2.0

V、VS、SCEで1時間電気化学的ドーピングを行った。溶媒で洗浄し乾燥した後、3mm×3mm サイズに切断し、カーボンペーストと緩ペースド で陰極を取り出して外袋樹脂をモールドし、コン デンサを作製した。

will be the control of the second of the sec

このコンデンサの電気的特性を第1表、第2表 に示す。

この実施例において、前記の電解ドーピングの 代わりにドーパントとして、ヨウ素、発煙破散、 臭素及び三酸化イオウを用い化学ドーピングを行 い電源度を測定したところ以下の結果を得た。

ドーパント	電導度(S/cm)			
ヨウ素	2 . 3 × 1 0 '			
発煙硫酸	3.5×10'			
臭 素	2 . 7 × 1 0 ¹			
三酸化イオウ	6.5×10*			

実施例 2

- ○ CH(OCH₃)- CH₂-の繰り返し単位をもつポリ(P-フェニレンピニレン)の前駆体ポ

リマー7重量%とジクロロメタン93重量%とシクロロメタン93重量%とジクロロメタン93重量%とシクロロメタン環境に処理した。現場に処理した後、アルゴンガ。のでは一方で1時間がでは、アルゴンが、では、アルゴンが、では、アルゴンが、では、アルゴンが、では、アルゴンが、では、アルガンで、アースをサファインで、アースをサファインが、アースをサファインが、アースをサファインが、アースをサファインが、では、アースをサファインが、では、アースをは、ア

特開平3-3310(5)

をもつポリ(P-フェニレンピニレン)前駆体ポリマーを使用して間根な処理を行った場合にも同様な処理を行った場合にも同様な結果を得た。

超 1 章

初期恆

ŧ	"	ם מ	1				
				Сар	Tan 8	ESR	LС
				(# F/en2)	(%)	at	at107
				-1000KHz			
						(Ω)	(µ A)
奖	尥	例	1	7.51	0.66	0.02	0.4
爽	粒	例	2	7.49	0.72	0.025	0.4
比	Q	例		4.14	3.58	0.3	1.0

(発明の効果)

以上評細に説明した過り、本発明の方法によれば溶解に容易に溶解することのできる前極体は対することが関係なから、いるな上に直接に被顕形成することが困難な行って容易に形成することができる。また処理によって容易に形成することができる。ない、いるなのを全国酸化物故園に忍び口を及ぼすことを深つとなる。

特許出回人 日本ケミコン株式会社 代 取 人 弁取士 杉 林 邱 麻

第2段

2000時間後

(107,105℃ 穷命試取)

	∆ Сар	Tan&	ESR	LC
	(%)	(%)	at	at 10 V
			100KH2	
			(Ω)	(µA)
突炮例 1	-2.1	1.74	0.05	0.01
突粒例 2	-2.7	2.03	0.058	0.02
比较例	-10	5.45	0.7	0.5

級中、比较例は従来の二酸化マンガンを密路質とする固体電路コンデンサで真施例1と同じアルミニウム電粒板に研験マンガンを含扱し250℃で20分同規成したものである。

試1級、第2級からみて本発明の固体で終コンデンサは比较例のものに比べて単位面和当たりの容 記が高く、損失位、 範値直列抵抗位及び利れで流 が低い特性を示し、また鳥安定性及び耐久性に促 れたものであることが判る。

なお、この爽施例によれば、菜子の悶哲部に収

t.